Электронная структура янусовских слоев на основе $\mathsf{Ti}_{1-y}\mathsf{Cr}_y(\mathsf{Se}_{1-x}\mathsf{S}_x)_2$

© Д.В. Беляев 1 , Ю.Е. Коваленко 1 , А.А. Титов 1 , В.А. Голяшов 2,3 , О.Е. Терещенко 2,3 , Р.Г. Чумаков 4 , А.Н. Титов 1 , Т.В. Кузнецова 1,5

630559 р. п. Кольцово, Россия

E-mail: danil.belyaev08@gmail.com

Поступила в Редакцию 19 апреля 2024 г. В окончательной редакции 16 октября 2024 г. Принята к публикации 16 апреля 2024 г.

Впервые синтезированы монокристаллы $T_{0.9}Cr_{0.1}(Se_{0.8}S_{0.2})_2$ и $T_{10.85}Cr_{0.15}(Se_{0.8}S_{0.2})_2$ методом газотранспортных реакций. Структурная и фазовая чистота полученных монокристаллов исследована методом порошковой рентгеновской дифракции. Химический состав синтезированных образцов, определен методом энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии на сканирующем электронном микроскопе. Исследование электронной структуры выполнено методом фотоэлектронной спектроскопии с угловым разрешением. При увеличении концентрации Сг наблюдается уменьшение заполнения зоны проводимости и уменьшение массы дырок. Также наблюдается отсутствие бездисперсионной полосы, что свидетельствует об отсутствии интеркаляции металла в межслоевое пространство.

Ключевые слова: янусовские структуры, фотоэлектронная спектроскопия с угловым разрешением, дихалькогениды переходных металлов.

DOI: 10.61011/FTP.2024.07.59179.6333H

1. Введение

Дихалькогениды переходных металлов представляют собой слоистые материалы с обобщенной формулой MX_2 (M = Ti, Zr, Mo, Hf; X = S, Se, Te). Внутри слоя атомы связаны между собой ионно-ковалентной связью, а между слоями формируется ван-дер-ваальсова связь, что позволяет рассматривать такие слои, как квази-2D структуры, и исследовать различные эффекты, связанные с размерностью образцов. Дихалькогениды переходных металлов проявляют уникальные свойства, такие как сверхпроводимость [1,2], волны зарядовой плотности [1,3], топологические свойства [1,4], что обеспечивает им широкую область практического применения, в частности в электронике [5], литиевых батареях [6] и фотодетекторах [7]. Одним из способов модификации свойств данных соединений является интеркаляция атомов или молекул в межслоевое пространство [8]. Другим путем изменения свойств дихалькогенидов является замещение по подрешетке металла [9]. В работе [10] показано, что в соединениях $Ti_{1-x}Cr_xSe_2$ происходит появление сверхстехиометричного металла, преимущественно Ті, в межслоевом пространстве при замещении

четырехвалентного титана (Ti^{4+}) трехвалентным хромом (Cr^{3+}) , что приводит к нарушению квази-2D структуры. Следовательно, для предотвращения самоинтеркаляции и сохранения квази-2D структуры необходимо внесение дополнительных электронов в систему. Это позволит осуществить полное замещение титана хромом [11] без формирования избыточного переходного металла между слоями.

Янусовские структуры привлекли огромный научный интерес в последнее время, что связано с появлением новых уникальных свойств, которые возникают из-за нарушения зеркальной симметрии за счет различных атомов на каждой стороне их элементарной ячейки, в таких материалах [12–14]. Данные соединения могут быть синтезированы на основе дихалькогенидов переходных металлов при замещении Se на S или наоборот, где структура S-M-Se представляет собой янусовский слой. В работе [15] для системы $TiSe_2-TiS_2$ была показана практически неограниченная растворимость компонентов. Это связано со схожестью их электронной и кристаллической структур. Оба соединения имеют тригональную кристаллическую решетку с пространственной группой P-3m1 (N 164), однако их параметры отличают-

¹ Институт физики металлов им. М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук, 620137 Екатеринбург. Россия

 $^{^2}$ Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук, 630090 Новосибирск, Россия

³ Центр коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" Федерального государственного бюджетного учреждения науки "Федеральный исследовательский центр "Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук",

⁴ Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт",

¹²³¹⁸² Москва. Россия

⁵ Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, 620002 Екатеринбург, Россия

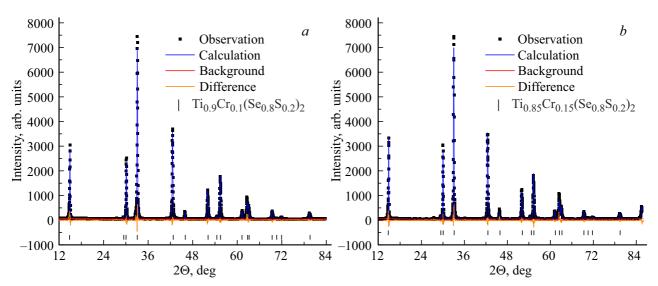


Рис. 1. Полнопрофильный анализ порошковой рентгеновской дифракции для образцов $Ti_{0.9}Cr_{0.1}(Se_{0.8}S_{0.2})_2$ (*a*) и $Ti_{0.85}Cr_{0.15}(Se_{0.8}S_{0.2})_2$ (*b*).

ся: $a_0 = 3.407 \,\text{Å}$ и $c_0 = 5.680 \,\text{Å}$ для TiS₂; $a_0 = 3.528 \,\text{Å}$ и $c_0 = 5.981 \,\text{Å}$ для TiSe₂. Также данные материалы близки и по своей электронной структуре: TiS₂ является узкозонным полупроводником с непрямой запрещенной зоной (~ 0.5 эВ), в котором вершина валентной зоны формируется р-орбиталью атомов халькогена в Г-точке зоны Бриллюэна (ЗБ), а дно зоны проводимости сформировано 3d состояниями титана в M-точке 3Б; для TiSe₂ вершина валентной зоны и дно зоны проводимости формируются аналогичным образом, что и для TiS2, при этом величина щели не превышает 0.05 эВ. В работе [16] было показано отсутствие каких-либо особенностей на спектрах фотоэлектронной спектроскопии с угловым разрешением (ФСУР, ARPES) в соединениях $TiSe_{2-x}S_x$ при замещении вплоть до x = 0.34, за исключением плавного изменения ширины запрещенной зоны между направлением Γ –М 3Б. Позже в работе [17] при анализе зависимости ЭДС электрохимической ячейки $\text{Li/Li}^+/\text{Ti}(\text{Se}_{1-x}\text{S}_x)_2/\text{Pt}$ было обнаружено снижение ЭДС электрохимической ячейки на величину до 0.5 эВ, как при замещении S на Se, так и при замещении Se на S при уровне замещения x = 0.2. Так как в исследуемом соединении отсутствуют атомы Li, то изменение ЭДС связано с ростом энергии Ферми в $Ti(Se_{1-x}S_x)_2$. Наблюдаемый рост энергии Ферми может проявляться в связи с донорной природой янусовских структур за счет возникновения лапласовского давления, потому что замещение Se на S является изовалентным, но из-за разных ионных радиусов может происходить искривление решетки. Следовательно, можно ожидать, что янусовские структуры в соединениях $Ti_{1-y}Cr_y(Se_{1-x}S_x)_2$ позволят осуществить замещение Ті на Ст без дополнительной интеркаляции металла в межслоевое пространство. Однако остается неясным, какое количество донорных электронов генерируется за счет формирования янусовских слоев.

В работе впервые синтезированы монокристаллы ${\rm Ti}_{1-y}{\rm Cr}_y({\rm Se}_{1-x}{\rm S}_x)_2$ методом газотранспортных реакций из предварительно подготовленной поликристаллической шихты. Структурная и фазовая чистота поликристаллов исследована методом порошковой рентгеновской дифракции (XPD). Химический состав монокристаллов изучен с помощью энергодисперсионного рентгеновского (EDX) анализа. Исследование электронной структуры монокристаллов выполнено методом фотоэлектронной спектроскопии с угловым разрешением (ARPES).

2. Материалы и методы исследования

Поликристаллические образцы $Ti_{0.85}Cr_{0.15}(Se_{0.8}S_{0.2})_2$ и $Ti_{0.9}Cr_{0.1}(Se_{0.8}S_{0.2})_2$ были синтезированы из высокочистых элементов (3N), навешанных в стехиометрическом соотношении. Синтез поликристаллической шихты осуществлялся в кварцевых вакуумированных ампулах $(10^{-5}\,\text{Торр})$ при 900°С в течение 5 сут. Затем полученные соединения были механически измельчены в ступке и спрессованы для улучшения контакта. Полученные прессовки были отожжены в вакуумированных ампулах в течение 5 дней при температуре 750°C. Монокристаллические образцы были выращены из поликристаллической шихты методом газотранспортных реакций с Se в качестве носителя. Химический состав монокристаллов был определен с помощью EDX анализа на сканирующем электронном микроскопе Quanta 200 в Центре коллективного пользования ИФМ УрО РАН. Структура и фазовая чистота синтезированных поликристаллов исследованы методом XPD с помощью дифрактометpa XRD 7000 Maxima, $CuK_{\alpha} = 1.5418 \text{ Å} (\Delta x < 5\%).$ ARPES-измерения проводились вдоль направления $\Gamma - M$ зоны Бриллюэна при температуре 80 К и давлении ниже

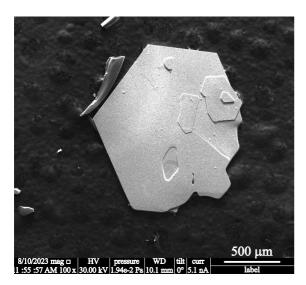


Рис. 2. СЭМ-изображение монокристалла $Ti_{0.85}Cr_{0.15}(Se_{0.8}S_{0.2})_2$.

 10^{-10} мбар с помощью системы фотоэлектронной спектроскопии SPECS Proven-X ARPES, оборудованной гелиевым газоразрядным источником ультрафиолетового излучения UVS-300 ($hv=21.22\,\mathrm{pB}$) и полусферическим анализатором энергий электронов ASTRAIOS 190, в Институте физики полупроводников им. А. Ржанова в Новосибирске. Расщепление образцов проводилось в сверхвысоком вакууме ($<10^{-10}\,\mathrm{mfap}$) при комнатной температуре. Для характеризации дальнего кристаллического порядка, а также для определения направлений высокой симметрии на поверхности образцов после скола использовалась дифракция медленных электронов (LEED).

3. Результаты и обсуждение

Порошковая дифрактограмма и полнопрофильный соединений $Ti_{0.85}Cr_{0.15}(Se_{0.8}S_{0.2})_2$ $Ti_{0.9}Cr_{0.1}(Se_{0.8}S_{0.2})_2$ представлены на рис. 1. По результатам полнопрофильного анализа установлена однофазность синтезированных систем. Пространственная группа соединений Р-3м1 (№ 164), параметры элементарной ячейки $Ti_{0.85}Cr_{0.15}(Se_{0.8}S_{0.2})_2$ для составляют $a = 3.513 \,\text{Å}$, $c = 5.930 \,\text{Å}$, $V = 63.399 \,\text{Å}^3$, $Ti_{0.9}Cr_{0.1}(Se_{0.8}S_{0.2})_2$ составляют $a = 3.513 \,\text{Å},$ $c = 5.941 \,\text{Å}, \ V = 63.515 \,\text{Å}^3$. Уровень самоинтеркаляции результатам полнопрофильного анализа превышает 4.5%.

На рис. 2 показан внешний вид типичного монокристалла, выращенного в процессе синтеза. На основе результатов EDX-анализа было обнаружено, что состав исследуемых монокристаллов имеет небольшие отклонения от стехиометрии $Ti_{0.87}Cr_{0.13}(Se_{0.77}S_{0.23})_{1.87}$ вместо $Ti_{0.85}Cr_{0.15}(Se_{0.8}S_{0.2})_2$ и $Ti_{0.91}Cr_{0.09}(Se_{0.78}S_{0.22})_{1.85}$ вместо $Ti_{0.9}Cr_{0.1}(Se_{0.8}S_{0.2})_2$.

На рис. 3 показаны данные ARPES для монокристаллов $Ti_{0.85}Cr_{0.15}(Se_{0.8}S_{0.2})_2$ и $Ti_{0.9}Cr_{0.10}(Se_{0.8}S_{0.2})$ в направлении $\Gamma-M$ 3Б. Наблюдается дисперсионная зависимость, что свидетельствует о кристаллической квази-2D структуре образцов и отсутствии самоинтеркаляции. Также наблюдается наличие непрямозонной щели ~ 0.08 эВ. Кроме этого, наблюдается наличие смещенной зоны в валентной зоне в Γ -точке 3Б. Эта смещенная зона может быть связана с формированием янус-структур, содержащих Cr.

Наблюдаемые отличия от стехиометрии могут быть связаны с погрешностью метода определения химического состава образца либо с наличием интеркалированного металла в межслоевое пространство, так как

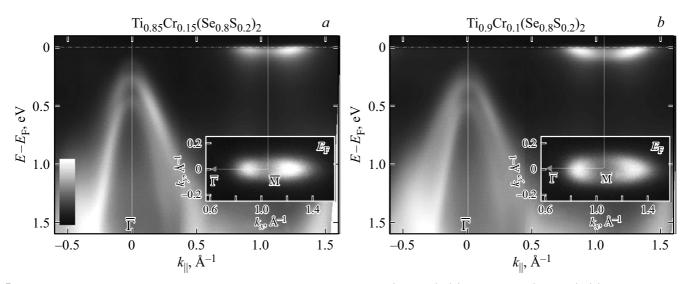


Рис. 3. Спектры ARPES для поверхности монокристаллов $Ti_{0.85}Cr_{0.15}(Se_{0.8}S_{0.2})$ (a) и $Ti_{0.9}Cr_{0.10}(Se_{0.8}S_{0.2})$ (b), измеренные в направлении $M-\Gamma-M$ при $T=80\,\mathrm{K},\ hv=21.22\,\mathrm{sB}.$ На вставках показаны соответствующие карты поверхности Ферми вблизи M-точки.

соотношение между Ті и Ст, как и соотношение между Se и S, близко к желаемому, однако соотношение Me: Ch = 1:2 не сохраняется (здесь под Me подразумевается совместное содержание атомов Ст и Ті, а под Ch — совместное содержание атомов Se и S). В нашем случае наиболее вероятен первый вариант, так как по результатам ХРО показано, что самоинтеркаляция в межслоевое пространство не превышает 4.5% и на спектрах ARPES отсутствуют характерные для интеркалированных атомов бездисперсионные зоны. Согласно данным анализа спектров ARPES, наблюдается снижение интенсивности сигнала со дна зона проводимости при повышении содержания хрома в образцах, что связано с замещением Ті на Ст в подрешетке металла, а также наблюдается уменьшение эффективной массы дырок по мере увеличения концентрации хрома, т.е. $m_{\text{holes Cr0.15}} < m_{\text{holes Cr0.1}}$, так как дисперсия зон для образца, содержащего Сто.1, больше, чем у образца, содержащего Сто.15.

4. Заключение

синтезированы монокристаллы $Ti_{0.85}Cr_{0.15}(Se_{0.80}S_{0.20})_2$ и $Ti_{0.90}Cr_{0.10}(Se_{0.80}S_{0.20})_2$ методом газотранспортных реакций. По результатам полнопрофильного анализа показана однофазность образцов и определены параметры элементарной ячейки. С помощью EDX анализа был определен химический состав синтезированных монокристаллов. Отклонение от стехиометрического соотношения связано с погрешностью метода. По данным ARPES установлено отсутствие бездисперсионной зоны, что свидетельствует об отсутствии интеркаляции металла в межслоевое пространство. Показано наличие непрямозонной щели $\sim 0.08\,{\rm sB}.$ Дополнительно наблюдается смещенная зона, которая может быть связана с образованием янус-структур, содержащих Сг. Выявлены снижение интенсивности сигнала на дне зоны проводимости при росте концентрации хрома в образце, что связано с замещением атомов Ті на атомы Ст в подрешетке металла, и уменьшение массы дырок по мере увеличения концентрации атомов хрома.

Финансирование работы

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда № 23-72-00067. Авторы (ЦКП "СКИФ" В.А. Голяшов и О.Е. Терещенко) благодарят Министерство науки и высшего образования РФ за финансовую поддержку в рамках государственного задания ЦКП "СКИФ" Института катализа СО РАН.

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

- [1] S. Manzeli, D. Ovchinnikov, D. Pasquier, O.V. Yazyev, A. Kis. Nature Rev. Mater., 2, 1 (2017).
- [2] W. Shi, J. Ye, Y. Zhang, R. Suzuki, M. Yoshida, J. Miyazaki, N. Inoue, Y. Saito, Y. Iwasa. Sci. Rep., 5, 12534 (2015).
- [3] P. Chen, Y.-H. Chan, X.-Y. Fang, Y. Zhang, M.Y. Chou, S.-K. Mo, Z. Hussain, A.-V. Fedorov, T.-C. Chiang. Nature Commun., 6, 8943 (2015).
- [4] M.K. Hooda, C.S. Yadav, D. Samal. J. Phys.: Condens. Matter, 33, 103001 (2020).
- [5] J. Yu, C.-H. Lee, D. Bouilly, M. Han, P. Kim, M.L. Steigerwald, X. Roy, C. Nuckolls, Nano Lett., 16, 3385 (2016).
- [6] S. Fan, X. Zou, H. Du, L. Gan, C. Xu, W. Lv, Y.-B. He, Q.-H. Yang, F. Kang, J. Li. J. Phys. Chem. C, 121, 13599 (2017).
- [7] K. Zhang, X. Fang, Y. Wang, Y. Wan, Q. Song, W. Zhai, Y. Li[†], G. Ran, Y. Ye, L. Dai. ACS Appl. Mater. Interfaces, 9, 5392 (2017).
- [8] N. Sirica, S.-K. Mo, F. Bondino, I. Pis, S. Nappini, P. Vilmercati, J. Yi, Z. Gai, P.C. Snijders, P.K. Das, I. Vobornik, N. Ghimire, M.R. Koehler, L. Li, D. Sapkota, D.S. Parker, D.G. Mandrus, N. Mannella. Phys. Rev. B, 94, 075141 (2016).
- [9] A.S. Shkvarin, Y.M. Yarmoshenko, A.I. Merentsov, E.G. Shkvarina, A.F. Gubkin, I. Piš, S. Nappini, F. Bondino, I.A. Bobrikov, A.N. Titov. Inorg. Chem., 59, 8543 (2020)
- [10] A.N. Titov, A.I. Merentsov, V.N. Neverov. Phys. Solid State, 48, 1472 (2006).
- [11] J.M. Tarascon, F.J. DiSalvo, M. Eibschutz, D.W. Murphy, J.V. Waszczak. Phys. Rev. B, 28, 6397 (1983).
- [12] A. Kandemir, H. Sahin. Phys. Rev. B, 97, 155410 (2018).
- [13] J. Zhang, S. Jia, I. Kholmanov, L. Dong, D. Er, W. Chen, H. Guo, Z. Jin, V.B. Shenoy, L. Shi, J. Lou. ACS Nano, 11, 8192 (2017).
- [14] D.B. Trivedi, G. Turgut, Y. Qin, M.Y. Sayyad, D. Hajra, M. Howell, L. Liu, S. Yang, N.H. Patoary, H. Li, M.M. Petrić, M. Meyer, M. Kremser, M. Barbone, G. Soavi, A.V. Stier, K. Müller, S. Yang, I.S. Esqueda, H. Zhuang, J.J. Finley, S. Tongay. Adv. Mater., 32, 2006320 (2020).
- [15] R. Nitsche. Fortschr. Miner., 44, 231 (1967).
- [16] M.-L. Mottas, T. Jaouen, B. Hildebrand, M. Rumo, F. Vanini, E. Razzoli, E. Giannini, C. Barreteau, D.R. Bowler, C. Monney, H. Beck, P. Aebi. Phys. Rev. B, 99, 155103 (2019).
- [17] A.N. Titov, A.S. Shkvarin, A.I. Merentsov, O.V. Bushkova, E.A. Suslov, A.A. Titov, J. Avila, M.C. Asensio, N.V. Kazantseva, M.S. Postnikov. Chem. Mater., 33, 8915 (2021).

Редактор А.Н. Смирнов

Electronic structure of Janus layers based on $Ti_{1-y}Cr_y(Se_{1-x}S_x)_2$

D.V. Beliaev¹, Yu.E. Kovalenko¹, A.A. Titov¹, V.A. Golyashov^{2,3}, O.E. Tereshchenko^{2,3}, R.G. Chumakov⁴, A.N. Titov¹, T.V. Kuznetsova^{1,5}

Mikheev Institute of Metal Physics,
Ural Branch of the Russian Academy of Sciences,
620137 Yekaterinburg, Russia
Rzhanov Institute of Semiconductor Physics,
Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences,
630090 Novosibirsk, Russia
Synchrotron Radiation Facility —
Siberian Circular Photon Source "SKIF"
Boreskov Institute of Catalysis of Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences,
630559 Koltsovo, Russia
National Research Center "Kurchatov Institute",
123182 Moscow, Russia
Ural Federal University named after the First President

of Russia B.N. Yeltsin, 620002 Ekaterinburg, Russia

Abstract Single crystals $Ti_{0.9}Cr_{0.1}(Se_{0.8}S_{0.2})_2$ and $Ti_{0.85}Cr_{0.15}(Se_{0.8}S_{0.2})_2$ were synthesized for the first time by gas-transport reactions. The structural and phase purity of the obtained single crystals was investigated by powder X-ray diffraction. The chemical composition of the synthesized samples was determined by energy dispersive X-ray spectroscopy on a scanning electron microscope. The electronic structure was studied by Angle-resolved Photoemission Spectroscopy method. With increasing Cr concentration, a decrease in conduction band filling and a decrease in hole mass is observed. The absence of dispersion-free band is also observed, which indicates the absence of metal intercalation into the interlayer space.